

	<h2>SI7810DN-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7810DN-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 3.4A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7810DN-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 50574 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7810DN-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 3.4A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	50574 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 3.4A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	62 mOhm @ 5.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7810DN-T1-E3TR

SI7810DN-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7810DN-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7810DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7810DN-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7810DN-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 3.4A 1212-8</p>	 <p>SI7810DN-T1-E VISHAY SI7810DN-T1-E VISHAY</p>	 <p>SI7810DN-T1 VISHAY SI7810DN-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7812DN SI SI7812DN SI</p>
 <p>SI7810DN VISHAY SI7810DN VISHAY</p>	 <p>SI7810DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 3.4A 1212-8</p>	 <p>SI7811DN SI SI7811DN SI</p>	 <p>SI7806DN-T1-GE3 VB SI7806DN-T1-GE3 VB</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI7790DP-T1-E3	↔ SI7790DP-T1-GE3	⇒ SI7790DP-T1-GE3	D SI7792DP-T1-GE3	↔ SI7792DP-T1-GE3
⊣ SI7794DP-T1-GE3	⊛ SI7794DP-T1-GE3	D SI7798DP-T1-GE3	⇒ SI7804DN	↔ SI7804DN-T1-E3
⊛ SI7804DN-T1-E3	⊣ SI7806ADN	⊛ SI7806ADN-T1-E3	↔ SI7806ADN-T1-E3	↔ SI7806ADN-T1-E3-PBF
D SI7806ADN-T1-GE3	⊛ SI7806ADN-T1-GE3	⊣ SI7806AEDN-T1-E3	⊛ SI7806BDN	↔ SI7806BDN-T1-GE3
⇒ SI7806DN-T1-E3	↔ SI7806DN-T1-GE3	⊛ SI7810DN	⊣ SI7810DN-T1	↔ SI7810DN-T1-E
↔ SI7810DN-T1-E3	⇒ SI7812DN-T1-E3	D SI7812DN-T1-E3	⊛ SI7812DN-T1-GE3	⊣ SI7812DN-T1-GE3
⊛ SI7818DN-T1-E3	D SI7818DN-T1-E3	⇒ SI7820DN-T1-E3	↔ SI7820DN-T1-E3	↔ SI7820DN-T1-GE3
⊣ SI7820DN-T1-GE3	⊛ SI7840BDP	↔ SI7840BDP-T1-E3	⇒ SI7840BDP-T1-E3	↔ SI7840BDP-T1-GE3
⊛ SI7840BDP-T1-GE3	⊣ SI7840DP	⊛ SI7840DP-T1	D SI7840DP-T1-E3	↔ SI7840DP-T1-GE3
↔ SI7840DP-T1-GE3.	⊛ SI7842DP	⊣ SI7842DP-T1-E3	⊛ SI7842DP-T1-E3	↔ SI7842DP-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited